

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Measurement of quartz crystal unit parameters –
Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)**

**Mesure des paramètres des résonateurs à quartz –
Partie 6: Mesure de la dépendance du niveau d'excitation (DNE)**





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 60444-6

Edition 2.0 2013-06

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Measurement of quartz crystal unit parameters –
Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)**

**Mesure des paramètres des résonateurs à quartz –
Partie 6: Mesure de la dépendance du niveau d'excitation (DNE)**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

R

ICS 31.140

ISBN 978-2-83220-876-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 DLD effects	6
3.1 Reversible changes in frequency and resistance	6
3.2 Irreversible changes in frequency and resistance	6
3.3 Causes of DLD effects.....	7
4 Drive levels for DLD measurement	7
5 Test methods.....	8
5.1 Method A (Fast standard measurement method)	8
5.1.1 Testing at two drive levels	8
5.1.2 Testing according to specification.....	8
5.2 Method B (Multi-level reference measurement method)	9
Annex A (normative) Relationship between electrical drive level and mechanical displacement of quartz crystal units	11
Annex B (normative) Method C: DLD measurement with oscillation circuit	14
Bibliography.....	19
Figure 1 – Maximum tolerable resistance ratio γ for the drive level dependence as a function of the resistances R_{r2} or R_{r3}	9
Figure B.1 – Insertion of a quartz crystal unit in an oscillator	14
Figure B.2 – Crystal unit loss resistance as a function of dissipated power	15
Figure B.3 – Behaviour of the R_r of a quartz crystal units	16
Figure B.4 – Block diagram of circuit system.....	16
Figure B.5 – Installed $-R_{osc}$ in scanned drive level range	17
Figure B.6 – Drive level behavior of a quartz crystal unit if $-R_{osc} = 70 \Omega$ is used as test limit in the “Annex B” test	17
Figure B.7 – Principal schematic diagram of the go/no-go test circuit.....	18

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASUREMENT OF QUARTZ CRYSTAL UNIT PARAMETERS –**Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60444-6 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) DLD measurement with oscillation circuit had the traditional method to detect the DLD abnormal modes at present time. Therefore, this method made the transition to the Annex B.
- b) High reliability crystal unit is needed to use for various applications at the present day, in order to upgrade the inspection capabilities for DLD abnormal modes, the multi-level reference measurement method was introduced into this specification.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
49/1004/CDV	49/1038/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60444 series, published under the general title *Measurement of quartz crystal unit parameters*, can be found on the IEC website.

INTRODUCTION

The drive level (expressed as power/voltage across or current through the crystal unit) forces the resonator to produce mechanical oscillations by way of piezoelectric effect. In this process, the acceleration work is converted to kinetic and elastic energy and the power loss to heat. The latter conversion is due to the inner and outer friction of the quartz resonator.

The frictional losses depend on the velocity of the vibrating masses and increase when the oscillation is no longer linear or when critical velocities, elongations or strains, excursions or accelerations are attained in the quartz resonator or at its surfaces and mounting points (see Annex A). This causes changes in resistance and frequency, as well as further changes due to the temperature dependence of these parameters.

At “high” drive levels (e.g. above 1 mW or 1 mA for AT-cut crystal units) changes are observed by all crystal units and these also can result in irreversible amplitude and frequency changes. Any further increase of the drive level may destroy the resonator.

Apart from this effect, changes in frequency and resistance are observed at “low” drive levels in some crystal units, e.g. below 1 mW or 50 μ A for AT-cut crystal units). In this case, if the loop gain is not sufficient, the start-up of the oscillation is difficult. In crystal filters, the transducer attenuation and ripple will change.

Furthermore, the coupling between a specified mode of vibration and other modes (e.g. of the resonator itself, the mounting and the back-fill gas) also depends on the level of drive.

Due to the differing temperature response of these modes, these couplings give rise to changes of frequency and resistance of the specified mode within narrow temperature ranges. These changes increase with increasing drive level. However, this effect will not be considered further in this part of IEC 60444.

The first edition of IEC 60444-6 was published in 1995. However, it has not been revised until today. In the meantime the demand for tighter specification and measurement of DLD has increased.

In this new edition, the concept of DLD in IEC 60444-6:1995 is maintained. However, the more suitable definition for the user's severe requirements was introduced. Also, the specifications based on the matters arranged in the Stanford meeting in June, 2011 are taken into consideration.

MEASUREMENT OF QUARTZ CRYSTAL UNIT PARAMETERS –

Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)

1 Scope

This part of IEC 60444 applies to the measurements of drive level dependence (DLD) of quartz crystal units. Two test methods (A and C) and one referential method (B) are described. “Method A”, based on the π -network according to IEC 60444-1, can be used in the complete frequency range covered by this part of IEC 60444. “Reference Method B”, based on the π -network or reflection method according to IEC 60444-1, IEC 60444-5 or IEC 60444-8 can be used in the complete frequency range covered by this part of IEC 60444. “Method C”, an oscillator method, is suitable for measurements of fundamental mode crystal units in larger quantities with fixed conditions.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60444-1, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a π -network – Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and resonance resistance of quartz crystal units by zero phase technique in a π -network*

IEC 60444-5, *Measurement of quartz crystal units parameters – Part 5: Methods for the determination of equivalent electrical parameters using automatic network analyzer techniques and error correction*

IEC 60444-8, *Measurement of quartz crystal unit parameters – Part 8: Test fixture for surface mounted quartz crystal units*

3 DLD effects

3.1 Reversible changes in frequency and resistance

Reversible changes are changes in frequency and resistance occurring under the same drive levels after repeated measurements made alternatively at low and high levels, or after continuous or quasi-continuous measurements from the lowest to the highest level and back, if these changes remain within the limits of the measurement accuracy.

3.2 Irreversible changes in frequency and resistance

Irreversible changes are significant changes in frequency and/or resistance occurring at low level after an intermediate measurement at high level e.g. when a previously high resistance at low level has changed in the repeated measurement to a low resistance. Especially, when the crystal unit has not been operated for several days, its resistance may have changed back to a high value when operated again at a lower level. Greater attention should be paid to the irreversible effect since it can significantly impair the performance of devices, which are operated only sporadically.

3.3 Causes of DLD effects

Whereas the mostly reversible effects are due to excessive crystal drive level, the irreversible effects are due to production, especially to imperfect production techniques. Examples of causes are:

- Particles on the resonator surface (partly bound by oils, cleaning agents, solvents or bound electro-statically);
- Mechanical damage of the resonator (e.g. fissures due to excessively coarse lapping abrasive which may increase in size);
- Gas and oil inclusions in the electrodes (e.g. due to a poor vacuum or an inadequate coating rate during evaporation);
- Poor contacting of the electrodes at the mounting (e.g. the conductive adhesive has an inadequate metal component, was insufficiently baked out or was overheated; also excessive contact resistance between the conductive adhesive and the electrodes or mounting);
- Mechanical stresses between mounting, electrodes and quartz element.

4 Drive levels for DLD measurement

For the DLD measurement, a low and a high level of drive (and possibly further levels) are applied. The high level is the nominal drive level, which should be equal to the level in the application at its steady state.

It should be noted that this level should be below the maximum applicable level that is derived in Annex A. If not specified, a standard value for the crystal current of 1 mA, corresponding to the velocity $v_{\max} = 0,2$ m/s for AT-cut crystal units, shall be used. The drive level in watts is then calculated with the mean value of the specified maximum and minimum resistances.

The minimum drive level occurring at the start-up of an oscillator can be determined only in a few cases by active or passive measuring methods due to the noise limits of the measuring instruments for measurements according to IEC 60444-1, at approximately 1 nW or 10 μ A (depending on the equipment, the lowest power value can be reduced to 0,1 nW or 1 μ A).

A velocity $v_{\max} = 0,01$ m/s, corresponding to 50 μ A for AT-cut crystals, has proved to be practical value for π -network measurements (see “Method A”).

In the following, two methods and one referential method of DLD measurement are described.

“Method A” is based on the π -network method according to IEC 60444-1, which can be used in the complete frequency range covered by this standard. It allows the fast selection of drive level sensitive quartz crystal units by a sequence of three measurements. The allowed variation of the resonance resistances given in Figure 1 is based on long-term examinations of crystal units of different manufacturers and proved to be a reliable indicator for crystal units showing start-up problems. If necessary, this method should also be extended by measuring a large number of different drive levels. However, in practice, this is not necessary in most cases (see 5.1).

“Method B” is used for devices where strict oscillation start-up requirements have to be fulfilled and for high reliability devices.

“Method C” in Annex B is an oscillator method, which is especially suitable for measuring fundamental mode crystal units in larger quantities with fixed measurement conditions (maximum drive level, $R_r \max$) in an economical way.

If the proposed measurement techniques are not sufficient in special cases, the user should have an original oscillator with slightly reduced feedback or an original filter.

“Method B” is stricter than “Method A”.

“Method B” is based on the π -network method or reflection method according to IEC 60444-1, IEC 60444-5 or IEC 60444-8, which can be used in the complete frequency range covered by this standard.

Recommendation: These methods can be used for all types of crystals, however:

- “Method A” is recommended for filter and oscillator crystals.
- “Method B” is recommended for applications with strict start-up conditions, for high reliability and for high stability applications. It is the reference method for failure analysis etc.
- “Method C” in Annex B is a go/no-go measurement technique for oscillator crystals.

5 Test methods

5.1 Method A (Fast standard measurement method)

5.1.1 Testing at two drive levels

Testing is performed at low and high drive levels as described in Clause 3 with measurements of resonance frequency and resistance according to IEC 60444-1. The tolerances are $\pm 10\%$ for the levels of current and $\pm 20\%$ for those of power.

- a) Storage for at least one day at 105 °C and after that at least 2 hours at room temperature or, storage for one week at room temperature.
- b) The temperature should be kept constant during the measurement (in accordance with IEC 60444-1 and IEC 60444-5).
- c) Measurement at low drive level (10 μ A): $f_r = f_{r1}$, $R_r = R_{11}$.
- d) Measurement at high drive level (1 mA): $f_r = f_{r2}$, $R_r = R_{12}$.
- e) Measurement at low drive level (10 μ A): $f_r = f_{r3}$, $R_r = R_{13}$.
- f) Calculation of $\gamma_{12} = R_{11}/R_{12}$. The value of γ_{12} shall be smaller than the maximum value of γ given by the line drawn in Figure 1 (abscissa = R_{12}).
- g) The tolerable frequency change $|f_{r2} - f_{r1}|$ shall be $5 \times 10^{-6} \times f_{r1}$ unless otherwise specified in the detail specification.
- h) Calculation of $\gamma_{13} = R_{11}/R_{13}$. The value of γ_{13} shall be smaller than $(\gamma + 1)/2$, where the value of γ is taken from Figure 1 (abscissa = R_{13}).
- i) The tolerable frequency change $|f_{r3} - f_{r1}|$ shall be $2,5 \times 10^{-6} \times f_{r1}$, unless otherwise specified in the detail specification.
- j) The resistance value shall not exceed the maximum value given by the detail specification at any drive levels.

5.1.2 Testing according to specification

Testing is performed at low to high drive levels and back again to low level as described in 5.1.1. These and, if necessary, further levels with their tolerances, the permissible deviations of the frequency and resistance as well as storage conditions shall be specified in the detail specification.

NOTE 1 The given γ -curve was verified by results obtained over many years of experience with crystal units for many oscillator types. In most cases, there will be no trouble in start-up, but in critical oscillator configurations, problems may occur. As it is not possible to manufacture crystal units, which have a constant resistance at any drive level, the proposed γ -curve gives tolerable relations.

Definition of drive level values can be agreed between manufacturer and customer.

Use the nominal drive level of the detail specification as value for the high drive level. For measurement at very high drive levels an additional amplifier may be required.

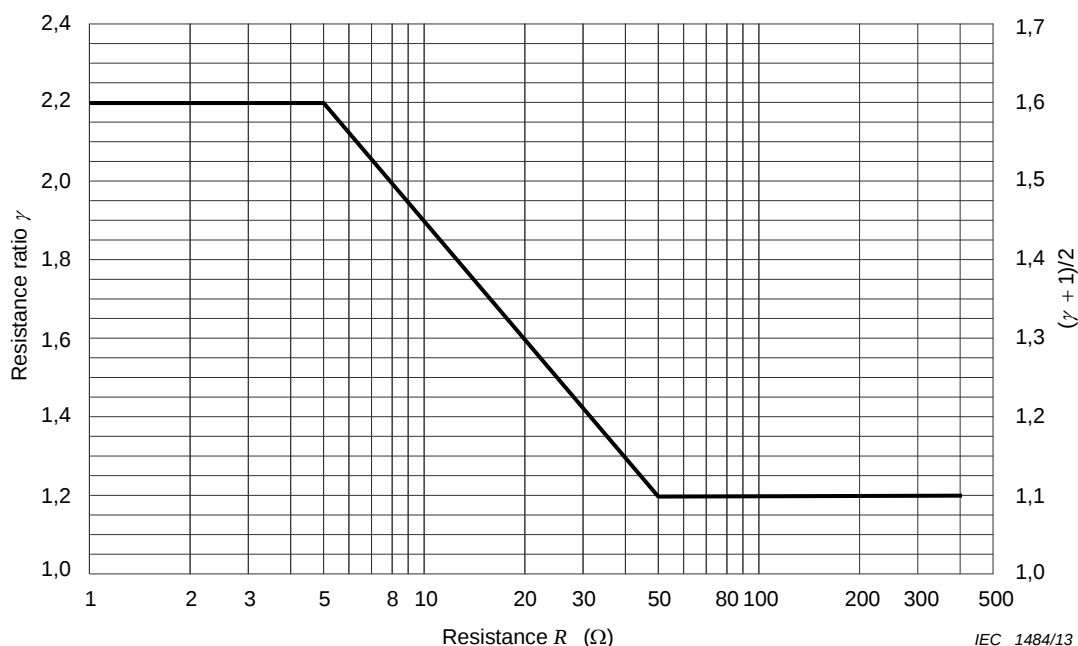


Figure 1 – Maximum tolerable resistance ratio γ for the drive level dependence as a function of the resistances R_{r2} or R_{r3}

NOTE 2 The equation for the recommended drive level (if not otherwise specified in the data sheet) is as follows. Details can be found in Annex A of IEC 60122-2-1:1991, Amendment 1:1993.

$$I_q = K \cdot \frac{nA}{\sqrt{f}}$$

where,

- I_q is the recommended current for oscillating state;
- n is the overtone, fundamental vibration mode, $n = 1$;
- A is the electrode size in mm^2 ;
- f is the frequency in MHz;
- K is $0,35 \text{ mA} \cdot \text{mm}^{-2} \cdot \text{S}^{-1/2}$.

5.2 Method B (Multi-level reference measurement method)

Testing is performed at low and high drive levels as described in Clause 3 with measurements of resonance frequency and resistance according to IEC 60444-5. The tolerances are $\pm 10\%$ for the levels of current and $\pm 20\%$ for those of power.

- a) Storage for at least one day at 105°C and after that at least 2 hours at room temperature or storage for one week at room temperature.

NOTE If considered as necessary, the customer and the maker agree on a higher temperature and a longer duration for the storage before DLD measurement.

- b) The temperature should be kept constant during the measurement IAW (in accordance with IEC 60444-5).
- c) The drive level is applied by two types of measurement units. It should also be applied sequentially starting from the lowest to the highest value and then back to the lowest value. A definition for the unit of drive levels shall be specified between the crystal manufacturer and the user.

- 1) When the unit of a drive level is mA;
Measurement drives level: from 2 μ A to nominal drive level in at least 7 levels which are logarithmically scaled. (Refer to the equation given under line item f)).
- 2) When the unit of a drive level is μ W;
Measurement drives level: From 2 nW to nominal drive level in at least 7 levels which are logarithmically scaled. (Refer to the equation given under line item f)).
- d) The maximum frequency excursion over all drive levels shall be less than following specifications.
 - (1) $\frac{f_{s(i),\max} - f_{s(i),\min}}{f_{\text{NOM}}} < 5 \times 10^{-6}$
or,
 - (2) $\frac{f_{s(i),\max} - f_{s(i),\min}}{f_{\text{NOM}}} < 0,5 \times f_{\text{ADJ}}$
where
 $f_{s(i),\max}$ is the maximum value for frequency measurement values with $i = 1$ to $2 \cdot N - 1$ drive levels;
 $f_{s(i),\min}$ is the minimum value for frequency measurement values with $i = 1$ to $2 \cdot N - 1$ drive levels;
 f_{NOM} is the nominal frequency;
 f_{ADJ} is the practical specification for frequency adjustment tolerance.
- e) The maximum ratio of resistance change and the maximum resistance over drive levels shall be as following specifications.
 - (1) $\frac{R_1(i),\max}{R_1(i),\min} < \gamma$
and
 - (2) $\frac{R_1(1)}{R_1(2 \cdot N - 1)} < \frac{(\gamma + 1)}{2}$
and
 - (3) $R_1(i),\max < R_{1,\max}$
where,
 $R_1(i),\max$ is the maximum value for resistance measurement values with $i = 1$ to $2 \cdot N - 1$ drive levels;
 $R_1(i),\min$ is the minimum value for resistance measurement values with $i = 1$ to $2 \cdot N - 1$ drive levels;
 $R_{1,\max}$ is the maximum resistance, specified by the detail specification.
 γ is the resistance ratio.
- f) The N drive levels should be logarithmically scaled, i.e. $DL_{N+1} = DL_N \times K$. The equation for the recommended drive level (if not otherwise specified in the data sheet) is as follows.

$$K = \left(\frac{DL_{\max}}{DL_{\min}} \right)^{\frac{1}{N-1}}$$

- g) A larger number of drive levels may be necessary in special applications, e.g. those caused by mechanical coupling with nonlinear spurious resonances (dips) and for failure analysis.

Annex A (normative)

Relationship between electrical drive level and mechanical displacement of quartz crystal units

The power loss of a crystal unit in watts is given by:

$$P_c = I^2 \cdot R_1$$

where

I is the current through the crystal unit in amperes.

R_1 is the motional resistance in ohms.

The reactive power is given by:

$$P_B = \frac{I^2}{2\pi f \cdot C_1} = P_c \cdot Q$$

where

f is the resonance frequency in hertz.

C_1 is the motional capacitance in farads.

Q is the quality factor.

The electric energy in watt seconds is given by:

$$A_{EL} = \frac{P_B}{f} = \frac{I^2}{2\pi f^2 \cdot C_1}$$

The mechanical energy of a crystal unit can be represented by the following terms:

$$A_{mech} = A_{kin} + A_{elast} + A_{pot} + A_B$$

$$A_{kin} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V \cdot v^2 \quad (\text{kinetic energy})$$

$$A_{elast} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot V \cdot x^2 \quad (\text{elastic energy})$$

$$A_{pot} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V \cdot s^2 \cdot (2\pi f)^2 \quad (\text{potential energy})$$

$$A_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho \cdot V \cdot b^2}{(2\pi f)^2} \quad (\text{acceleration work})$$

$$\rho = 2\,650 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{density})$$

where

- V is the volume of the oscillating area in cubic meters (m³);
 $v = ds/dt$ is the velocity in meters per seconds (m/s);
 c is the modulus of elasticity of the mode of vibration (for AT-cut crystal units,
 $c = c'_{66} = 2,93 \times 10^{10}$ N/m²)
 x is $\Delta l/l$ is the elongation;
 s is the excursion from rest position in meters;
 $b = d^2s/dt^2$ is the acceleration in meters per square seconds (m/s²);
 n is the overtone order.

The volume V can be calculated from the electrode area F_{EL} and the electrode spacing d .

From the static capacitance:

$$C_e = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{F_{EL}}{d} = C_0$$

where

- ε_r is the relative dielectric constant of AT-cut quartz material and is equal to 4,54;
 ε_0 is the electric field constant and is equal to $8,86 \times 10^{-12}$ F/m;
 N is the frequency constant equal to $f \cdot (d/n)$. $N = 1\,665$ Hz·m for AT-cut crystal units;
 n is the overtone order.

We obtain the following:

$$V = \frac{C_0}{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0} \cdot \frac{n^2 \cdot N^2}{f^2}$$

and the maximum current from the maximum velocities, elongations, excursions or accelerations of the mechanical vibrations:

$$I_{\max} = K_1 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot v_{\max} \quad \text{where} \quad K_1 = \sqrt{\frac{\pi \cdot \rho \cdot N^2}{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0}}$$

$$I_{\max} = K_2 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot x_{\max} \quad \text{where} \quad K_2 = \sqrt{\frac{\pi \cdot c \cdot N^2}{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0}}$$

$$I_{\max} = K_3 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot s_{\max} \quad \text{where} \quad K_3 = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi^3 \cdot \rho \cdot N^2}{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0}}$$

$$I_{\max} = K_4 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot \frac{b_{\max}}{f} \quad \text{where} \quad K_4 = \sqrt{\frac{\rho \cdot N^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0}}$$

For non-convex AT-cut crystal units, the following also applies:

$$C_0/C_1 = \gamma = 200 \cdot n^2$$

where

n is the overtone order.

The following is obtained with $C_0 = 5$ pF for the currents:

$I_{\max,1} = 50$ mA	$I_{\max,2} = 1$ mA
$v_1 = 0,01$ m/s	$v_2 = 0,2$ m/s
$x_1 = 1,8 \times 10^{-6}$	$x_2 = 3,6 \times 10^{-5}$

at $f = 10$ MHz:

$s_1 = 6,7 \times 10^{-11}$ m	$s_2 = 1,3 \times 10^{-9}$ m
$b_1 = 2,6 \times 10^5$ m/s ²	$b_1 = 5,3 \times 10^6$ m/s ²
$s_1 = 6,7 \times 10^{-12}$ m	$s_2 = 1,3 \times 10^{-10}$ m
$b_1 = 2,6 \times 10^6$ m/s ²	$b_2 = 5,3 \times 10^7$ m/s ²

Depending on the frequency, quality factor and mode of vibration of the crystal unit and the volume of the vibrating zone, maximum currents or levels result from limit considerations for every type of a crystal unit. These shall not be exceeded when using these devices in oscillators and filters.

The maximum drive level shall be selected so that with a further increase of the drive level by 50 %, the resistance does not increase reversibly by more than 10 % or the frequency changes by more than $0,5 \times 10^{-6}$.

Annex B (normative)

Method C: DLD measurement with oscillation circuit

To detect the DLD effect over the whole drive level range, the method described in 5.1 is very costly and is not applicable as a 100 % go/no-go test. The method proposed below tests the crystal units on its maximum R_r during start-up in an economical manner. This method can be applied as a 100 % final inspection as well as in a 100 % incoming inspection. It can also be used as an instrument to judge whether the crystal unit meets the requirements on $R_{r\max}$ given in the detail specification.

The crystal unit in the oscillator can be represented as indicated in Figure B.1.

There will be no oscillation when the magnitude of the $-R_{osc}$ of the circuit is lower than R_r of the crystal unit.

During start-up, the R_r of the crystal unit may behave as shown in Figure B.2.

When measuring the crystal unit several times, the characteristic can shift slightly to the right or to the left or it can flatten.

The ratio $\gamma = R_{r2}/R_{r1}$ may also differ from measurement to measurement. This ratio does not necessarily mean that the oscillator may stop working if a certain value of γ is reached. The most important aspect is the safety margin between the maximum occurring R_r of the crystal unit and the value of R_{osc} of the oscillator circuit.

It is recommended that the circuit should have a $|-R_{osc}|$ of $\geq 3|R_{r\max}|$ because in the temperature range, the $R_{r\max}$ as well as $-R_{osc}$ can shift.

During the start-up, the drive level will move from the low values (left side of the graphics in Figure B.3) to the nominal drive level.

The principle of measurement is presented in Figure B.4.

The test set-up consists of a carefully designed crystal oscillator which can be considered as a true negative resistance over a wide frequency range, a feedback network which limits the power dissipation in the crystal unit to 1 mW and a detector circuit with an LED for visual indication.

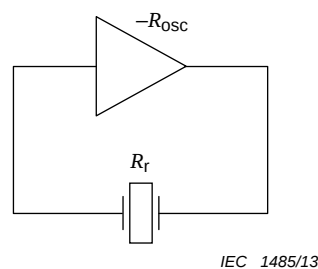


Figure B.1 – Insertion of a quartz crystal unit in an oscillator

Oscillation conditions:

- loop gain > 1 , which means $|-R_{osc}| > R_r$
- feedback signal at oscillator input shall have correct phase.

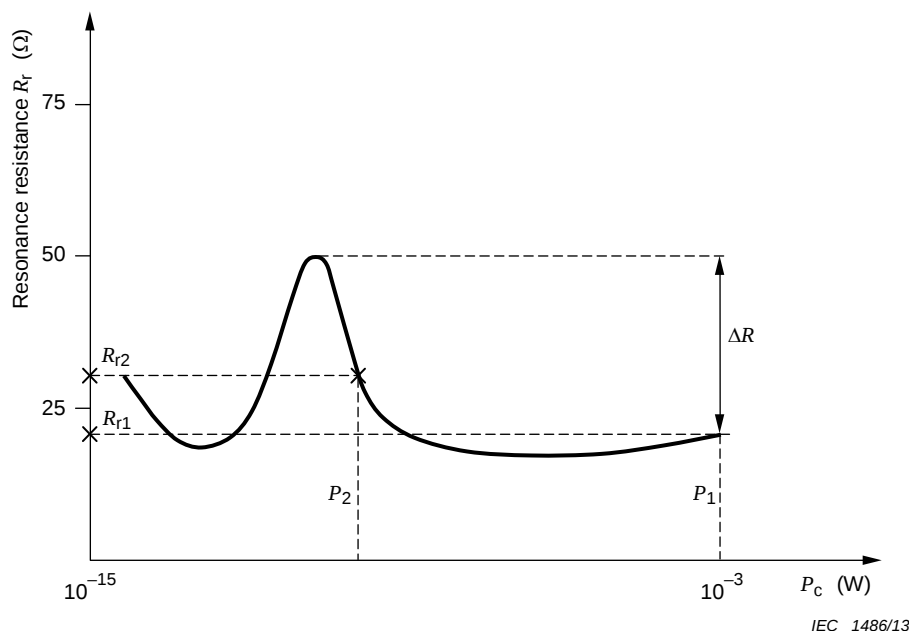


Figure B.2 – Crystal unit loss resistance as a function of dissipated power

NOTE The ratio R_{r2}/R_{r1} is not a reproducible value since the crystal unit curve slightly shifts at different measurement cycles.

The negative resistance (and with it the DLD reject level) of the oscillator can be changed by connecting a positive resistor in series with the oscillator. In this manner, each value between 0 Ω and 200 Ω may be selected. Connecting a quartz crystal unit with a sufficiently low R_r value between the test clamps, the oscillation will build up starting from the initial noise level (approximately 10^{-16} W to 10^{-15} W) to its limiting point for 1 mW as shown in Figure B.5.

During the start-up, the $R_{r,max}$ of the crystal unit is continuously compared with a Calibrated- R_{osc} and the result is detected and transferred into a go/no-go decision.

If the crystal unit under test shows a certain degree of DLD, it is possible that the oscillation amplitude will not reach the 1 mW limiting point (point B in Figure B.6). In the example given in Figure B.6, the build-up of the oscillation is terminated at a much lower level of drive (point A). Normally in such cases, no oscillation is observed and only with very sensitive equipment can some oscillation be detected.

If a crystal unit reaches the 1 mW level (point B), the LED indicator will light up. This means that the quartz crystal unit's resonance resistance did not exceed the DLD reject level during the start-up.

The advantages of this measurement method are that it is fast, easy to calibrate, inexpensive and it has a simple set-up. A detailed electrical diagram is shown in Figure B.7. The equipment is commercially available.

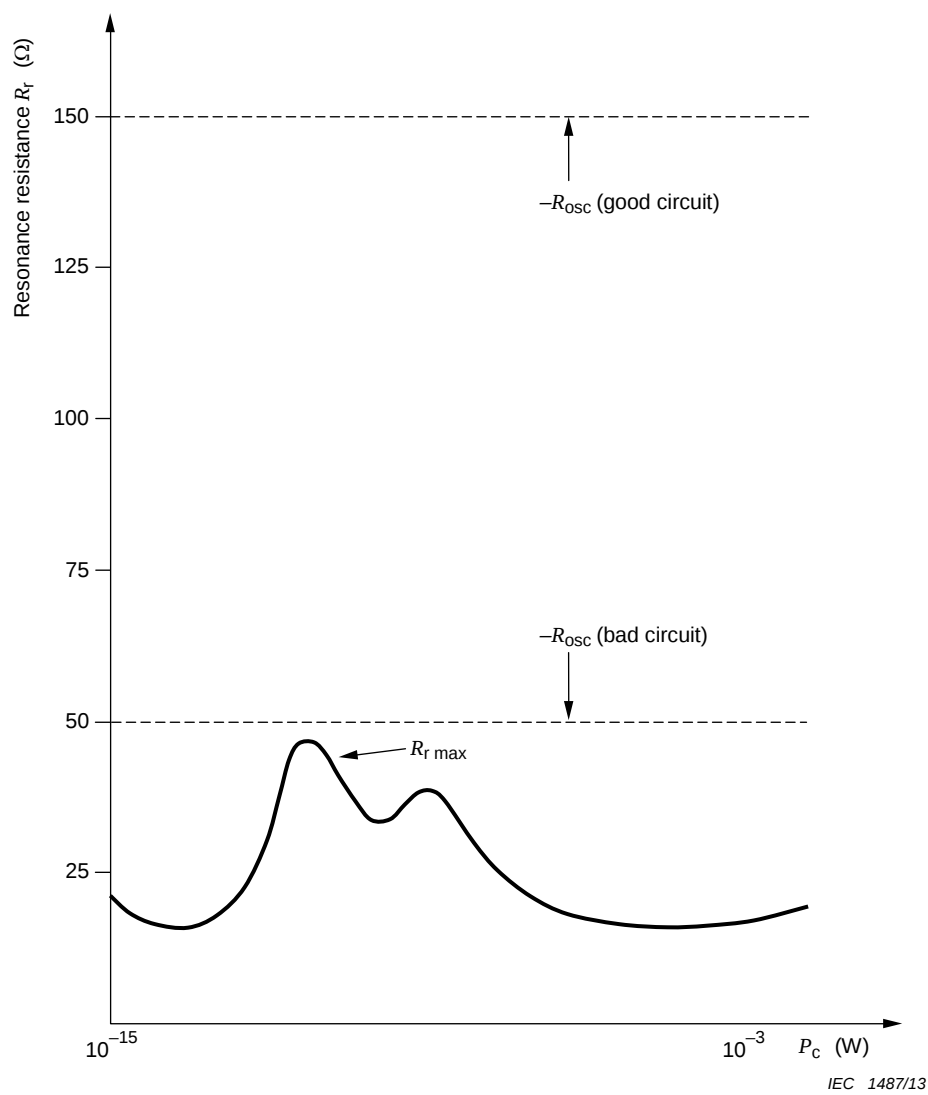


Figure B.3 – Behaviour of the R_r of a quartz crystal units

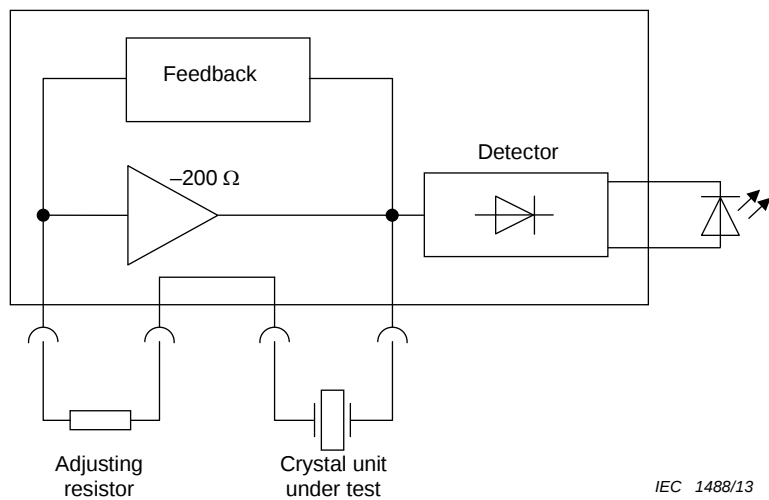


Figure B.4 – Block diagram of circuit system

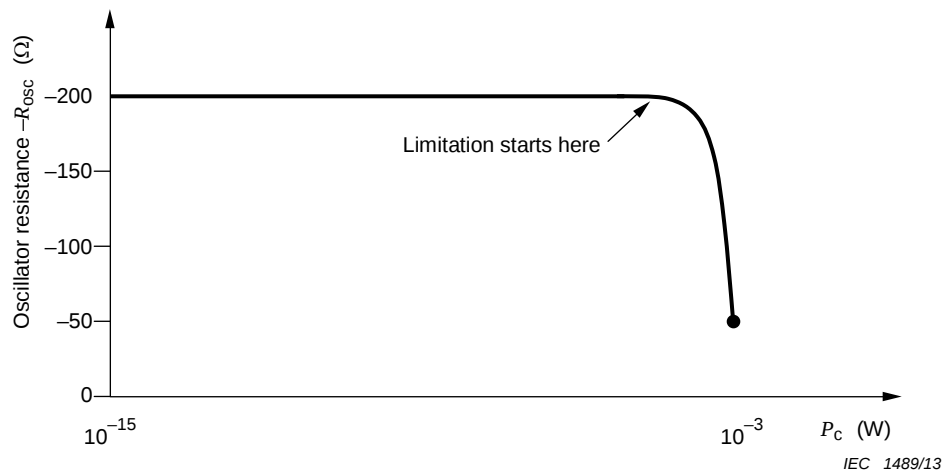


Figure B.5 – Installed $-R_{osc}$ in scanned drive level range

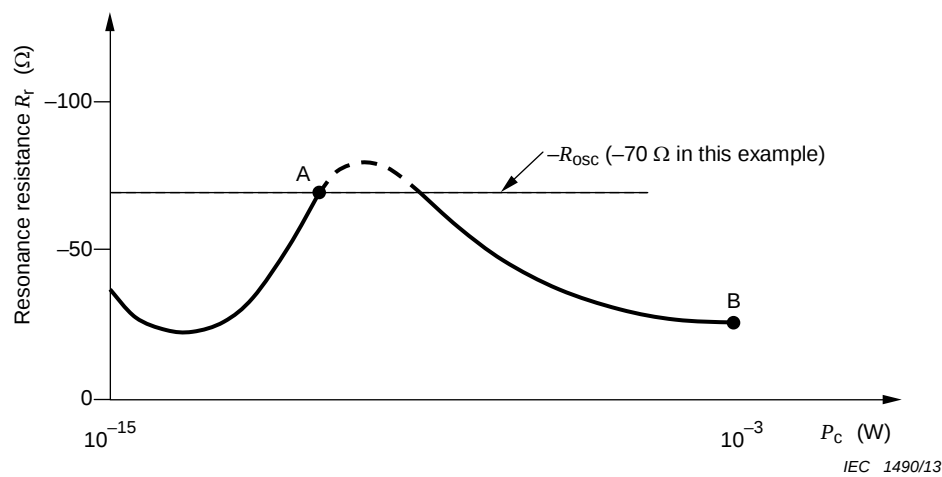
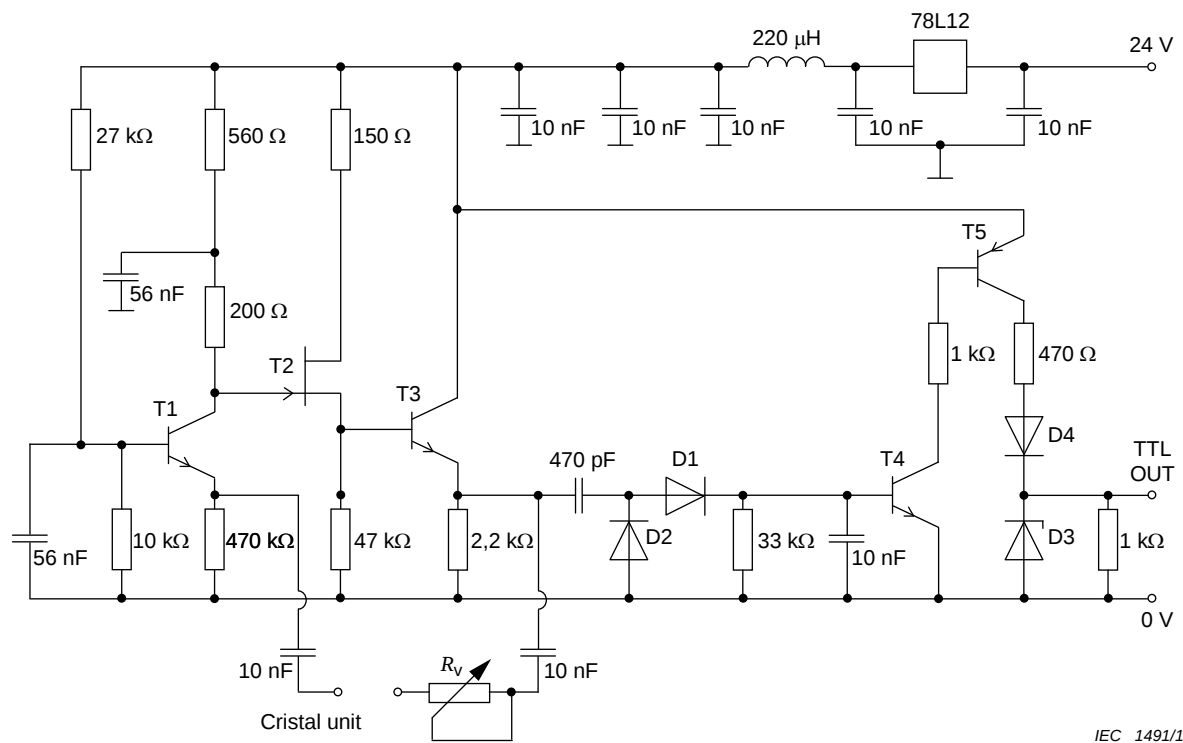


Figure B.6 – Drive level behavior of a quartz crystal unit if $-R_{osc} = 70 \Omega$ is used as test limit in the “Annex B” test



IEC 1491/13

Figure B.7 – Principal schematic diagram of the go/no-go test circuit

Bibliography

IEC 60122-2-1:1991, *Quartz crystal units for frequency control and selection – Part 2: Guide to the use of quartz crystal units for frequency control and selection – Section one: Quartz crystal units for microprocessor clock supply*
Amendment 1:1993

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	21
INTRODUCTION.....	23
1 Domaine d'application	24
2 Références normatives	24
3 Effets de la DNE	24
3.1 Changements réversibles de la fréquence et de la résistance.....	24
3.2 Changements irréversibles de la fréquence et de la résistance.....	24
3.3 Causes des effets de la DNE.....	25
4 Niveaux d'excitation pour la mesure de la DNE.....	25
5 Méthodes d'essai	26
5.1 Méthode A (méthode de mesure rapide normalisée)	26
5.1.1 Essai à deux niveaux d'excitation	26
5.1.2 Essai conformément à la spécification	27
5.2 Méthode B (méthode de mesure de référence à plusieurs niveaux)	28
Annexe A (normative) Relation entre le niveau d'excitation électrique et le déplacement mécanique des résonateurs à quartz.....	30
Annexe B (normative) Méthode C: Mesure de la DNE avec un circuit d'oscillation.....	33
Bibliographie.....	38
Figure 1 – Rapport des résistances maximales tolérables γ pour la dépendance du niveau d'excitation en fonction des résistances R_{r2} ou R_{r3}	27
Figure B.1 – Insertion d'un résonateur à quartz dans un oscillateur	33
Figure B.2 – Résistance de perte d'un résonateur en fonction de la puissance dissipée.....	34
Figure B.3 – Comportement de R_f d'un résonateur à quartz	35
Figure B.4 – Schéma de circuit	35
Figure B.5 – $-R_{osc}$ installée dans une gamme de niveaux d'excitation balayés.....	36
Figure B.6– Comportement du niveau d'excitation d'un résonateur à quartz si $-R_{osc} = 70 \Omega$ est utilisée comme limite de l'essai de l'Annexe B	36
Figure B.7 – Schéma principal du circuit d'essai tout-ou-rien	37

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE DES PARAMÈTRES DES RÉSONATEURS À QUARTZ –**Partie 6: Mesure de la dépendance du niveau d'excitation (DNE)****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60444-6 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1995. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) La mesure de DNE avec le circuit oscillation utilisait la méthode traditionnelle de détection des modes anormaux DNE au temps présent. Donc, cette méthode fait la transition avec l'Annexe B.
- b) La grande fiabilité de l'unité de cristal utilisé est nécessaire pour diverses applications actuelles, pour permettre de mettre à jour les capacités d'inspection des modes anormaux

des DNE, la méthode de mesure de référence de multi-niveaux a été présentée dans cette spécification.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
49/1004/CDV	49/1038/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60444, publiées sous le titre général *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

INTRODUCTION

Le niveau d'excitation (exprimé comme la puissance/la tension aux bornes du résonateur ou le courant qui traverse le résonateur) force le résonateur à produire des oscillations mécaniques par effet piézoélectrique. Dans ce processus, le travail d'accélération est converti en énergie cinétique et élastique et les pertes de puissance en chaleur. La dernière conversion est due au frottement interne et externe du résonateur à quartz.

Les pertes de frottement dépendent de la vitesse des masses vibrantes et elles augmentent lorsque l'oscillation n'est plus linéaire ou lorsque des vitesses critiques, des élongations ou des déformations, des excursions ou des accélérations sont atteintes dans le résonateur à quartz ou sur ses surfaces et points de montage (voir Annexe A). Cela provoque des changements de la résistance et de la fréquence, ainsi que des changements supplémentaires, du fait que ces paramètres dépendent de la température.

A des niveaux d'excitation "élevés" (par exemple supérieurs à 1 mW ou 1 mA pour des résonateurs de coupe AT) des changements sont observés sur tous les résonateurs et ils peuvent provoquer des changements irréversibles de l'amplitude et de la fréquence. Toute autre augmentation du niveau d'excitation peut détruire le résonateur.

A part cet effet, des changements de la fréquence et de la résistance sont observés dans certains résonateurs (par exemple inférieurs à 1 mW ou 50 μ A pour les résonateurs de coupe AT) à des niveaux d'excitation "bas". Dans ce cas, lorsque le gain de boucle n'est pas suffisant, le démarrage des oscillations est difficile. Dans les filtres à résonateurs, l'affaiblissement de transmission et l'ondulation changeront.

De plus, le couplage entre un mode de vibration spécifié et d'autres modes (par exemple du résonateur lui-même, du montage et du gaz de remplissage) dépend aussi du niveau d'excitation.

En raison des caractéristiques de température différentes de ces modes, ces couplages contribueront à des changements de la fréquence et de la résistance du mode spécifié dans des gammes de températures étroites. Ces changements augmentent avec l'élévation du niveau d'excitation. Cependant, cet effet ne sera pas considéré dans cette partie de la CEI 60444.

La première édition de la CEI 60444-6 a été publiée en 1995 et n'avait pas encore été révisée. Pendant ce temps, la demande de spécifications plus précises et de mesures de la dépendance du niveau d'excitation (DNE) s'est accrue.

Dans cette nouvelle édition, le concept de la DNE de la CEI 60444-6:1995 est maintenu. Toutefois, une définition mieux adaptée aux exigences strictes des utilisateurs a été introduite. Aussi, les spécifications basées sur les sujets évoqués lors de la conférence de Stanford en juin 2011 sont également prises en compte.

MESURE DES PARAMÈTRES DES RÉSONATEURS À QUARTZ –

Partie 6: Mesure de la dépendance du niveau d'excitation (DNE)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60444 s'applique aux mesures de la dépendance du niveau d'excitation (DNE) des résonateurs à quartz. Deux méthodes d'essai (A et C) et une méthode de référence (B) sont décrites. La méthode A, basée sur le réseau en π conformément à la CEI 60444-1, peut être utilisée dans la gamme des fréquences complète couverte par la présente partie de la CEI 60444. La méthode de référence B, basée sur le réseau en π ou sur la méthode de réflexion conformément à la CEI 60444-1, à la CEI 60444-5 ou à la CEI 60444-8, peut être utilisée dans la gamme des fréquences complète couverte par la présente partie de la CEI 60444. La méthode C, une méthode avec un oscillateur, est adaptée pour les mesures de résonateurs sur le mode fondamental en plus grandes quantités avec des conditions fixes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60444-1, *Mesure des paramètres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π – Première partie: Méthode fondamentale pour la mesure de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en π*

CEI 60444-5, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 5: Méthodes pour la détermination des paramètres électriques équivalents utilisant des analyseurs automatiques de réseaux et correction des erreurs*

CEI 60444-8, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 8: Dispositif d'essai pour les résonateurs à quartz montés en surface*

3 Effets de la DNE

3.1 Changements réversibles de la fréquence et de la résistance

Les changements réversibles sont des changements de la fréquence et de la résistance qui ont lieu avec les mêmes niveaux d'excitation après des mesures répétées effectuées alternativement aux niveaux faible et élevé, ou après des mesures continues ou quasi-continues du niveau le plus faible au niveau le plus élevé avant de revenir au niveau le plus faible, si ces changements restent dans les limites de la précision de mesure.

3.2 Changements irréversibles de la fréquence et de la résistance

Les changements irréversibles sont des changements significatifs de la fréquence et/ou de la résistance qui ont lieu au niveau bas après une mesure intermédiaire au niveau élevé, par exemple lorsqu'une résistance préalablement élevée, au niveau bas, est changée en résistance faible lorsque l'on refait la mesure. Spécialement lorsque le résonateur n'est pas utilisé pendant plusieurs jours, sa résistance peut revenir à une valeur élevée lorsqu'on l'utilise de nouveau à un niveau bas. Il convient de porter plus d'attention à l'effet irréversible

parce qu'il peut fortement compromettre la performance des dispositifs qui sont uniquement utilisés de manière irrégulière.

3.3 Causes des effets de la DNE

Tandis que les effets réversibles sont dans la plupart des cas dus au niveau d'excitation excessif du résonateur, les effets irréversibles sont dus à la production et surtout aux techniques imparfaites de production. Des exemples de causes sont:

- Des particules sur la surface du résonateur (déposées par des huiles, des agents de nettoyage, des solvants ou par voie électrostatique);
- Un endommagement mécanique du résonateur (par exemple des fissures en raison d'abrasif de polissage excessivement grossier, dont les dimensions peuvent augmenter);
- Des inclusions de gaz et d'huile dans les électrodes (par exemple en raison d'un vide de mauvaise qualité ou d'un taux de revêtement inapproprié pendant l'évaporation);
- Un mauvais contact des électrodes au niveau du montage (par exemple la pâte conductrice a un composant métallique inadéquat, ou elle est insuffisamment cuite ou surchauffée; aussi une résistance de contact excessive entre la pâte conductrice et les électrodes ou le montage);
- Des contraintes mécaniques entre le système de montage, les électrodes et le quartz.

4 Niveaux d'excitation pour la mesure de la DNE

Pour la mesure de la DNE, un niveau bas et un niveau élevé d'excitation (et éventuellement d'autres niveaux) sont appliqués. Le niveau élevé est le niveau d'excitation nominal. Il convient qu'il soit égal au niveau d'application en régime permanent.

Il convient de noter qu'il convient que ce niveau soit inférieur au niveau maximal applicable qui est donné dans l'Annexe A. Sauf spécification contraire, une valeur normalisée du courant du résonateur doit être de 1 mA, ce qui correspond à une vitesse $v_{\max} = 0,2$ m/s pour des résonateurs de coupe AT. Le niveau d'excitation en watts est alors calculé avec la valeur moyenne des résistances minimale et maximale spécifiées.

Le niveau d'excitation minimal qui a lieu pendant le démarrage d'un oscillateur peut être déterminé dans quelques cas seulement en utilisant les méthodes de mesure actives ou passives, en raison des limites de bruit des instruments de mesure pour des mesures conformes à la CEI 60444-1 à environ 1 nW ou 10 μ A (en fonction de l'équipement, la plus petite valeur de puissance peut être réduite à 0,1 nW ou 1 μ A).

Une vitesse $v_{\max} = 0,01$ m/s, correspondant à 50 μ A pour des résonateurs de coupe AT, est la valeur pratique reconnue pour des mesures dans le réseau en π (voir méthode A).

Dans le texte qui suit, deux méthodes et une méthode de référence de mesure de la DNE sont décrites.

La méthode A est basée sur la méthode du réseau en π conformément à la CEI 60444-1, qui peut être utilisée dans la gamme des fréquences complète couverte par la présente norme. Elle permet de choisir rapidement des résonateurs à quartz sensibles au niveau d'excitation par une séquence de trois mesures. La variation admissible des résistances de résonance données à la Figure 1, est basée sur des examens de longue durée des résonateurs de fabricants différents. Elle s'est révélée être une indication fiable pour les résonateurs ayant des problèmes de démarrage. Si nécessaire, il convient également d'étendre cette méthode en mesurant un grand nombre de niveaux d'excitation différents. Toutefois, dans la pratique, ce n'est pas nécessaire dans la plupart des cas (voir 5.1).

La méthode B est utilisée pour des dispositifs dans lesquels des exigences strictes de démarrage des oscillations doivent être respectées et pour des dispositifs de fiabilité élevée.

La méthode C de l'Annexe B est une méthode avec un oscillateur, qui est particulièrement adaptée pour la mesure de résonateurs sur le mode fondamental en plus grandes quantités avec des conditions de mesure fixes (niveau d'excitation maximal, R_r max) de manière économique.

Si les techniques de mesure proposées ne sont pas suffisantes dans des cas spéciaux, il convient que l'utilisateur ait un oscillateur d'origine avec un filtre de rétroaction légèrement réduite ou un filtre d'origine.

La méthode B est plus stricte que la méthode A.

La méthode B est basée sur la méthode du réseau en π ou sur la méthode de réflexion conformément à la CEI 60444-1, à la CEI 60444-5 ou à la CEI 60444-8, qui peut être utilisée dans la gamme des fréquences complète couverte par la présente norme.

Recommandation: ces méthodes peuvent être utilisées pour tous les types de résonateurs, toutefois:

- La méthode A est recommandée pour les résonateurs pour filtres et pour oscillateurs.
- La méthode B est recommandée pour des applications avec des conditions de démarrage strictes, de fiabilité élevée et de stabilité élevée. C'est la méthode de référence pour les analyses de défaillance, etc.
- La méthode C de l'Annexe B est une technique de mesure tout-ou-rien pour les résonateurs pour oscillateurs.

5 Méthodes d'essai

5.1 Méthode A (méthode de mesure rapide normalisée)

5.1.1 Essai à deux niveaux d'excitation

L'essai est effectué au niveau d'excitation bas et au niveau d'excitation élevé, comme décrit à l'Article 3 avec des mesures de la fréquence de résonance et de la résistance conformément à la CEI 60444-1. Les tolérances sont de ± 10 % pour les niveaux de courant et de ± 20 % pour les niveaux de puissance.

- a) Stockage pendant au moins un jour à 105 °C, puis pendant au moins 2 heures à température ambiante ou stockage pendant une semaine à température ambiante.
- b) Il convient de maintenir la température constante pendant la mesure (conformément à la CEI 60444-1 et à la CEI 60444-5).
- c) Mesure au niveau bas d'excitation (10 μ A): $f_r = f_{r1}$, $R_r = R_{11}$.
- d) Mesure au niveau élevé d'excitation (1 mA): $f_r = f_{r2}$, $R_r = R_{12}$.
- e) Mesure au niveau bas d'excitation (10 μ A): $f_r = f_{r3}$, $R_r = R_{13}$.
- f) Calcul de $\gamma_{12} = R_{11}/R_{12}$. La valeur de γ_{12} doit être inférieure à la valeur maximale de γ donnée par la ligne tracée sur la Figure 1 (abscisse = R_{12}).
- g) La variation de fréquence tolérable $|f_{r2} - f_{r1}|$ doit être $5 \times 10^{-6} \times f_{r1}$ sauf indication contraire dans la spécification particulière.
- h) Calcul de $\gamma_{13} = R_{11}/R_{13}$. La valeur de γ_{13} doit être inférieure à $(\gamma + 1)/2$, où la valeur de γ est tirée de la Figure 1 (abscisse = R_{13}).
- i) La variation de fréquence tolérable $|f_{r3} - f_{r1}|$ doit être $2,5 \times 10^{-6} \times f_{r1}$ sauf indication contraire dans la spécification particulière.
- j) La valeur de la résistance ne doit pas dépasser la valeur maximale donnée dans la spécification particulière pour n'importe quel niveau d'excitation.

5.1.2 Essai conformément à la spécification

L'essai est effectué du niveau bas d'excitation au niveau élevé d'excitation avant de revenir au niveau bas comme décrit en 5.1.1). Ces niveaux et, si nécessaire, d'autres niveaux avec leurs tolérances, les écarts admissibles de la fréquence et de la résistance ainsi que les conditions de stockage doivent être spécifiés dans la spécification particulière.

NOTE 1 La courbe γ donnée a été vérifiée en utilisant des résultats obtenus sur de nombreuses années d'expérience avec des résonateurs utilisés sur de nombreux types d'oscillateurs. Dans la plupart des cas, il n'y aura pas de problème au démarrage, mais pour des configurations d'oscillateurs critiques, des problèmes peuvent se produire. Puisqu'il n'est pas possible de fabriquer des résonateurs qui ont une résistance constante à n'importe quel niveau d'excitation, la courbe γ proposée donne des relations tolérables.

La définition des valeurs de niveaux d'excitation peuvent faire l'objet d'un accord entre le fabricant et le client.

Utiliser le niveau d'excitation nominal de la spécification particulière comme valeur du niveau élevé d'excitation. Pour les mesures à des niveaux d'excitation très élevés, un amplificateur additionnel peut être exigé.

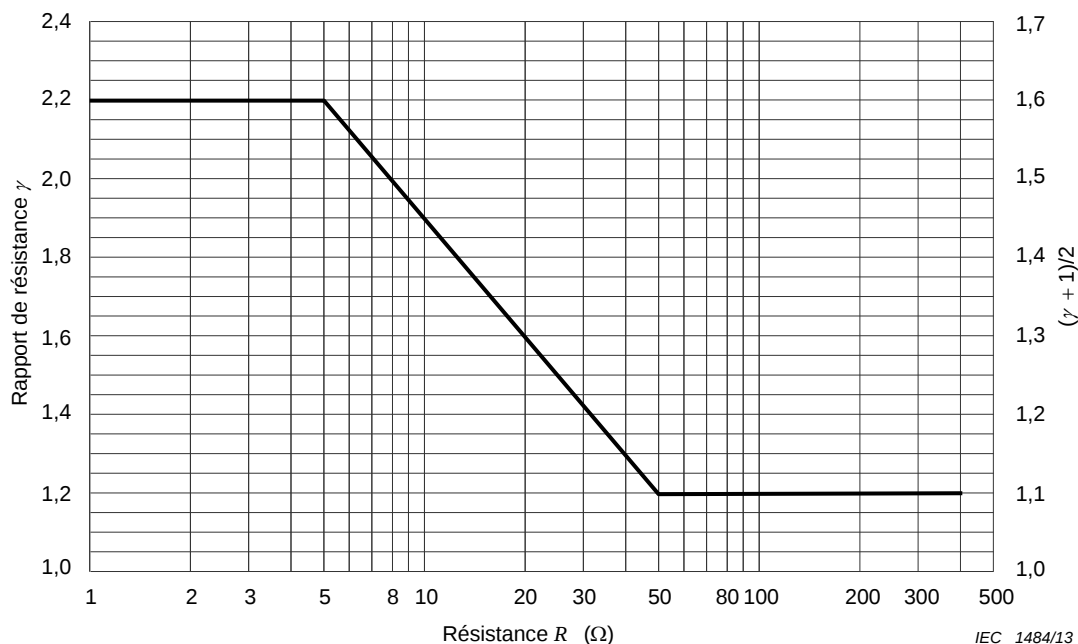


Figure 1 – Rapport des résistances maximales tolérables γ pour la dépendance du niveau d'excitation en fonction des résistances R_{r2} ou R_{r3}

NOTE 2 L'équation pour le niveau d'excitation recommandé (sauf spécification contraire dans la fiche technique) est la suivante. Les détails figurent à l'Annexe A de la CEI 60122-2-1:1991, Amendement 1:1993.

$$I_q = K \cdot \frac{nA}{\sqrt{f}}$$

Où,

I_q est le courant recommandé pour l'état d'oscillation,

n est l'harmonique supérieur (le mode de vibration fondamental est $n = 1$),

A est la taille de l'électrode en mm^2 ,

f est la fréquence en MHz

K est $35 \text{ mA} \cdot \text{mm}^{-2} \cdot \text{S}^{-1/2}$.

5.2 Méthode B (méthode de mesure de référence à plusieurs niveaux)

L'essai est effectué au niveau d'excitation bas et au niveau d'excitation élevé, comme décrit à l'Article 3 avec des mesures de la fréquence de résonance et de la résistance conformément à la CEI 60444-5. Les tolérances sont de $\pm 10\%$ pour les niveaux de courant et de $\pm 20\%$ pour les niveaux de puissance.

- a) Stockage pendant au moins un jour à 105°C , puis pendant au moins 2 heures à température ambiante ou stockage pendant une semaine à température ambiante.

NOTE Si nécessaire, le client et le fabricant approuvent une température plus élevée et une durée plus longue de stockage avant une mesure de la DNE.

- b) Il convient de maintenir la température constante pendant la mesure (conformément à la CEI 60444-5).

- c) Le niveau d'excitation est appliqué en utilisant deux types d'unités de mesure. Il convient également d'appliquer les niveaux d'excitation de manière séquentielle de la plus petite à la plus grande valeur, puis en revenant à la plus petite valeur. Une définition pour l'unité des niveaux de commande doit être spécifiée entre le fabricant du cristal et l'utilisateur.

- 1) Lorsque l'unité du niveau d'excitation est le mA;

Niveau d'excitation de mesure: de $2\ \mu\text{A}$ au niveau d'excitation nominal en au moins 7 niveaux répartis de manière logarithmique. (Se reporter à l'équation donnée au point f)).

- 2) Lorsque l'unité du niveau d'excitation est le μW ;

Niveau d'excitation de mesure: de $2\ \text{nW}$ au niveau d'excitation nominal en au moins 7 niveaux répartis de manière logarithmique. (Se reporter à l'équation donnée au point f)).

- d) L'excursion de fréquence maximale sur l'ensemble des niveaux d'excitation doit être inférieure aux spécifications suivantes.

$$(1) \frac{f_s(i)_{\max} - f_s(i)_{\min}}{f_{\text{NOM}}} < 5 \times 10^{-6}$$

ou

$$(2) \frac{f_s(i)_{\max} - f_s(i)_{\min}}{f_{\text{NOM}}} < 0,5 \times f_{\text{ADJ}}$$

où

$f_s(i)_{\max}$ est la valeur maximale pour les valeurs de la fréquence de mesure avec $i = 1$ à $2 \cdot N - 1$ comme niveaux d'excitation;

$f_s(i)_{\min}$ est la valeur minimale pour les valeurs de la fréquence de mesure avec $i = 1$ à $2 \cdot N - 1$ comme niveaux d'excitation;

f_{NOM} est la fréquence nominale;

f_{ADJ} est la spécification pratique pour la tolérance d'ajustement de la fréquence.

- e) Le rapport maximal de la variation de résistance et la résistance maximale du niveau d'excitation doit être conforme aux spécifications suivantes.

$$(1) \frac{R_1(i)_{\max}}{R_1(i)_{\min}} < \gamma$$

et

$$(2) \frac{R_1(1)}{R_1(2 \cdot N - 1)} < \frac{(\gamma + 1)}{2}$$

et

$$(3) R_1(i)_{\max} < R_{1,\max}$$

où

- $R_{1(i),\max}$ est la valeur maximale pour les valeurs de la mesure de la résistance avec $i = 1$ à $2 \cdot N - 1$ comme niveaux d'excitation;
 $R_{1(i),\min}$ est la valeur minimale pour les valeurs de la mesure de la résistance avec $i = 1$ à $2 \cdot N - 1$ comme niveaux d'excitation;
 $R_{1,\max}$ est la résistance maximale, spécifiée par la spécification détaillée,
 γ est le rapport de résistance.
- f) Il convient que les N niveaux d'excitation soient répartis de manière logarithmique, c'est-à-dire $DL_{N+1} = DL_N \times K$. L'équation pour le niveau d'excitation recommandé (sauf spécification contraire dans la fiche technique) est la suivante.

$$K = \left(\frac{DL_{\max}}{DL_{\min}} \right)^{\frac{1}{N-1}}$$

- g) Un plus grand nombre de niveaux d'excitation peut être nécessaire dans des applications spéciales, par exemple dans le cas de couplage mécanique avec des résonances parasites non linéaires (creux) et pour les analyses de défaillance.

Annexe A (normative)

Relation entre le niveau d'excitation électrique et le déplacement mécanique des résonateurs à quartz

La perte de puissance d'un résonateur en watts est donnée par:

$$P_c = I^2 \cdot R_1$$

où

I est le courant traversant le résonateur en ampères.

R_1 est la résistance dynamique en ohms.

La puissance réactive est donnée par:

$$P_B = \frac{I^2}{2\pi f \cdot C_1} = P_c \cdot Q$$

où

f est la fréquence de résonance en hertz.

C_1 est la capacité dynamique en farads.

Q est le facteur de qualité.

L'énergie électrique en watts secondes est donnée par:

$$A_{EL} = \frac{P_B}{f} = \frac{I^2}{2\pi f^2 \cdot C_1}$$

L'énergie mécanique d'un résonateur peut être représentée par les termes suivants:

$$A_{meca} = A_{cin} + A_{elast} + A_{pot} + A_B$$

$$A_{cin} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V \cdot v^2 \quad (\text{énergie cinétique})$$

$$A_{elast} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot V \cdot x^2 \quad (\text{énergie élastique})$$

$$A_{pot} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V \cdot s^2 \cdot (2\pi f)^2 \quad (\text{énergie potentielle})$$

$$A_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho \cdot V \cdot b^2}{(2\pi f)^2} \quad (\text{travail d'accélération})$$

$$\rho = 2\,650 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{densité})$$

où

V est le volume de la partie oscillante en mètre-cube (m^3).

$v = ds/dt$ est la vitesse en mètre par seconde (m/s).

c est le module d'élasticité du mode de vibration (pour les résonateurs de coupe AT, $c = c'_{66} = 2,93 \times 10^{10}$ N/m²)

x est $\Delta l/l$ est l'élongation.

s est déplacement depuis la position de repos en mètres.

$b = d^2s/dt^2$ est l'accélération en mètre par seconde carré (m/s²).

n est l'ordre du mode partiel.

Le volume V peut être calculé à partir de l'aire des électrodes F_{EL} et de l'espacement d entre les électrodes.

A partir de la capacité statique:

$$C_e = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{F_{EL}}{d} = C_0$$

où

ϵ_r est la constante diélectrique relative du quartz de coupe AT et est égale à 4,54.

ϵ_0 est la constante de champ électrique qui est égale à $8,86 \times 10^{-12}$ F/m.

N est la constante de fréquence égale à $f \cdot (d/n)$. ($N = 1\,665$ Hz·m pour les résonateurs de coupe AT)

n est l'ordre du mode partiel.

On obtient la relation suivante:

$$V = \frac{C_0}{\epsilon_r \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{n^2 \cdot N^2}{f^2}$$

et le courant maximal à partir des vitesses, élongations, excursions ou accélérations maximales des vibrations mécaniques:

$$I_{\max} = K_1 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot v_{\max} \text{ où } K_1 = \sqrt{\frac{\pi \cdot \rho \cdot N^2}{\epsilon_r \cdot \epsilon_0}}$$

$$I_{\max} = K_2 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot x_{\max} \text{ où } K_2 = \sqrt{\frac{\pi \cdot c \cdot N^2}{\epsilon_r \cdot \epsilon_0}}$$

$$I_{\max} = K_3 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot s_{\max} \text{ où } K_3 = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi^3 \cdot \rho \cdot N^2}{\epsilon_r \cdot \epsilon_0}}$$

$$I_{\max} = K_4 \cdot n \cdot \sqrt{C_0 \cdot C_1} \cdot \frac{b_{\max}}{f} \text{ où } K_4 = \sqrt{\frac{\rho \cdot N^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0}}$$

Pour les résonateurs de coupe AT non convexes, la relation suivante s'applique également:

$$C_0/C_1 = \gamma = 200 \cdot n^2$$

où

n est l'ordre du mode partiel.

Les données suivantes sont obtenues avec $C_0 = 5$ pF pour les courants:

$$I_{\max,1} = 50 \text{ mA}$$

$$I_{\max,2} = 1 \text{ mA}$$

$$v_1 = 0,01 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 0,2 \text{ m/s}$$

$$x_1 = 1,8 \times 10^{-6}$$

$$x_2 = 3,6 \times 10^{-5}$$

à $f = 10$ MHz:

$$s_1 = 6,7 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$s_2 = 1,3 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$b_1 = 2,6 \times 10^5 \text{ m/s}^2$$

$$b_1 = 5,3 \times 10^6 \text{ m/s}^2$$

$$s_1 = 6,7 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$s_2 = 1,3 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$b_1 = 2,6 \times 10^6 \text{ m/s}^2$$

$$b_2 = 5,3 \times 10^7 \text{ m/s}^2$$

Selon la fréquence, le facteur de qualité et le mode de vibration ainsi que le volume de la zone vibrante du résonateur, les courants ou les niveaux maximum résultent des conditions limites pour chaque type de résonateur. Ceux-ci ne doivent pas être dépassés dans l'utilisation de ces dispositifs dans les oscillateurs ou les filtres.

Le niveau d'excitation maximal doit être choisi de façon qu'une augmentation supplémentaire du niveau d'excitation de 50 % n'augmente pas la résistance de manière réversible de plus de 10 % ni la variation de fréquence de plus de $0,5 \times 10^{-6}$.

Annexe B (normative)

Méthode C: Mesure de la DNE avec un circuit d'oscillation

Pour détecter l'effet de la DNE sur toute la gamme des niveaux d'excitation, la méthode décrite en 5.1 est très coûteuse et elle n'est pas applicable comme un essai à 100 % en tout-ou-rien. La méthode proposée ci-dessous soumet les résonateurs à des essais à la valeur maximale de R_r pendant le démarrage d'une manière économique. Cette méthode peut être appliquée en inspection finale à 100 % ainsi qu'en inspection d'entrée à 100 %. Elle peut aussi être utilisée pour vérifier si le résonateur est conforme aux exigences de $R_{r\max}$ données dans la spécification particulière.

Le résonateur dans l'oscillateur peut être représenté comme indiqué à la Figure B.1.

Il n'y aura pas d'oscillation lorsque l'amplitude de $-R_{osc}$ du circuit est inférieure à R_r du résonateur.

Pendant le démarrage, R_r du résonateur peut avoir un comportement similaire à celui représenté à la Figure B.2.

Pendant des mesures répétées du résonateur, la caractéristique peut se décaler légèrement vers la droite ou vers la gauche, ou elle peut rester constante.

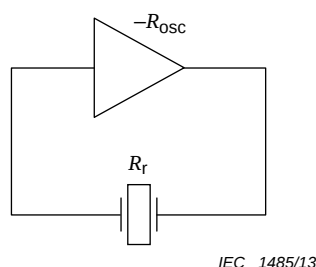
Le rapport $\gamma = R_{r2}/R_{r1}$ peut également être différent d'une mesure à l'autre. Ce rapport ne signifie pas nécessairement que l'oscillateur peut s'arrêter si une certaine valeur de γ est atteinte. L'aspect le plus important est une marge de sécurité entre R_r maximal du résonateur et la valeur de R_{osc} du circuit oscillateur.

Il convient que le circuit satisfasse à la condition $|-R_{osc}| \geq 3|R_{r\max}|$ parce que dans la gamme de températures, $R_{r\max}$ ainsi que $-R_{osc}$ peuvent se décaler.

Pendant le démarrage, le niveau d'excitation passera des valeurs basses (partie gauche des graphiques de la Figure B.3) au niveau d'excitation nominal.

Le principe de mesure est représenté à la Figure B.4.

Le banc d'essai consiste en un oscillateur à quartz soigneusement conçu qui peut être considéré comme une résistance négative vraie sur une large gamme de fréquences, un réseau de rétroaction limitant la dissipation de puissance sur le résonateur à 1 mW et un circuit détecteur avec une indication visuelle par LED.



IEC 1485/13

Figure B.1 – Insertion d'un résonateur à quartz dans un oscillateur

Conditions d'oscillation:

- le gain de boucle est supérieur à 1, ce qui signifie $|-R_{osc}| > R_r$
- le signal de rétroaction à l'entrée de l'oscillateur doit avoir une phase correcte.

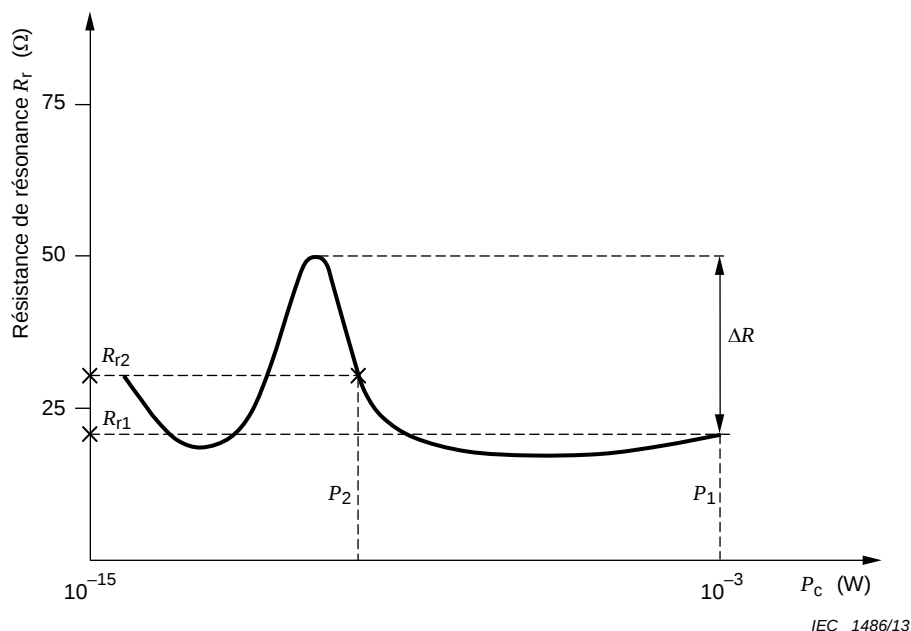


Figure B.2 – Résistance de perte d'un résonateur en fonction de la puissance dissipée

NOTE Le rapport R_{r2}/R_{r1} n'est pas une valeur reproductible parce que la courbe d'un résonateur varie légèrement pour différents cycles de mesure.

La résistance négative (et ainsi le niveau de réjection de la DNE) de l'oscillateur peut être changée en connectant une résistance positive en série avec l'oscillateur. De cette manière, on peut choisir chaque valeur entre 0 Ω et 200 Ω. En connectant un résonateur à quartz avec une valeur de R_r suffisamment basse entre les bornes d'essai, l'oscillation se formera à partir du niveau de bruit initial (de 10^{-16} W à 10^{-15} W approximativement) jusqu'à sa valeur limite de 1 mW comme cela est représenté à la Figure B.5.

Pendant le démarrage, $R_{r,max}$ du résonateur est continuellement comparée à $-R_{osc}$ étalonnée et le résultat est détecté et transféré à une décision tout-ou-rien.

Si le résonateur en essai montre un certain degré de DNE, il est possible que l'amplitude des oscillations n'atteigne pas la limite de 1 mW (point B de la Figure B.6). Dans l'exemple de la Figure B.6, la formation des oscillations se termine à un niveau d'excitation beaucoup plus faible (point A). Habituellement, dans de tels cas, on n'observe pas d'oscillations et seules certaines oscillations peuvent être observées à l'aide d'un équipement très sensible.

Si un résonateur atteint le niveau de 1 mW (point B), l'indicateur à LED s'allumera. Cela signifie que la résistance de résonance d'un résonateur à quartz ne dépasse pas le niveau de suppression de la DNE pendant le démarrage.

Les avantages de cette méthode de mesure sont qu'elle est rapide, facile à étalonner, peu coûteuse et son montage est simple. Un schéma électrique détaillé est représenté à la Figure B.7. L'équipement est disponible dans le commerce.

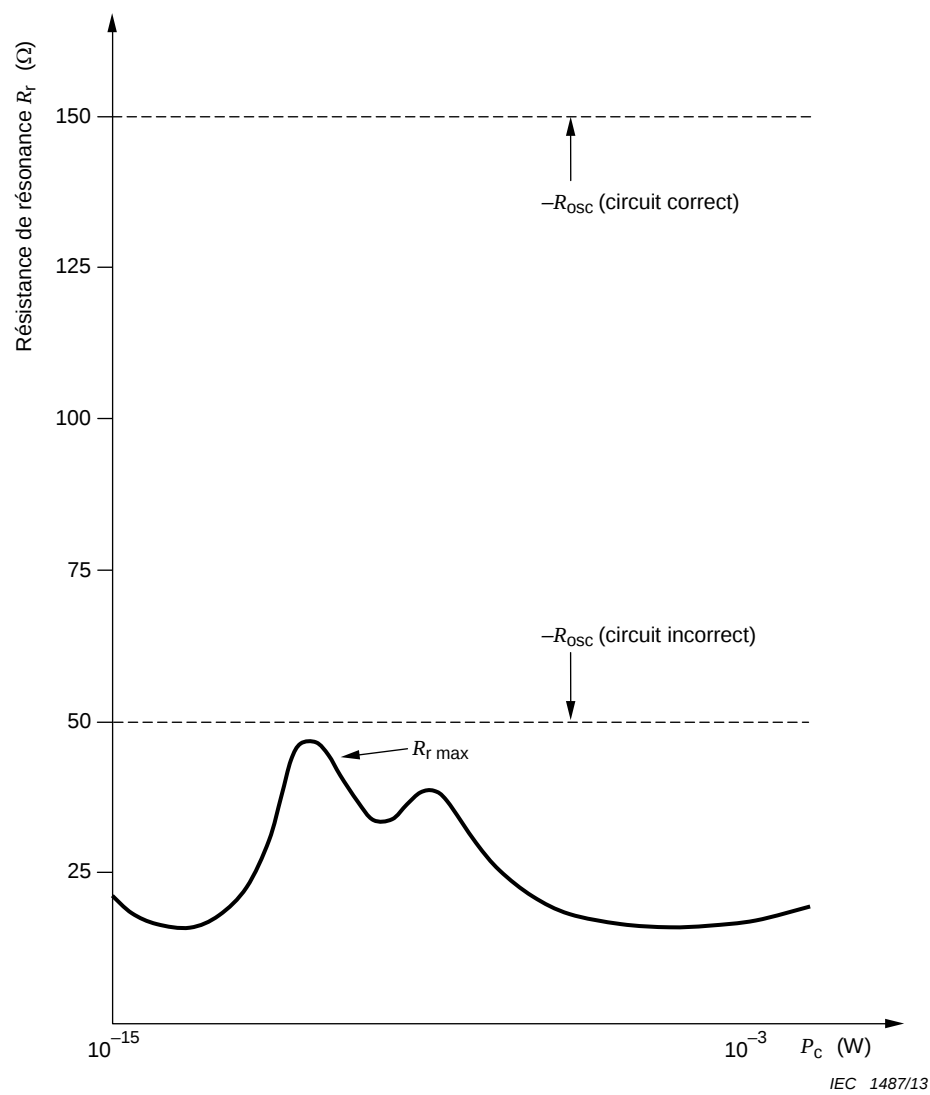


Figure B.3 – Comportement de R_r d'un résonateur à quartz

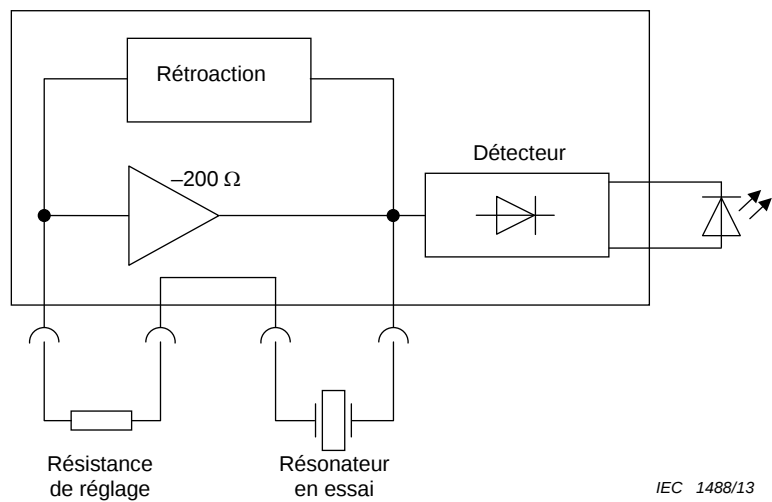


Figure B.4 – Schéma de circuit

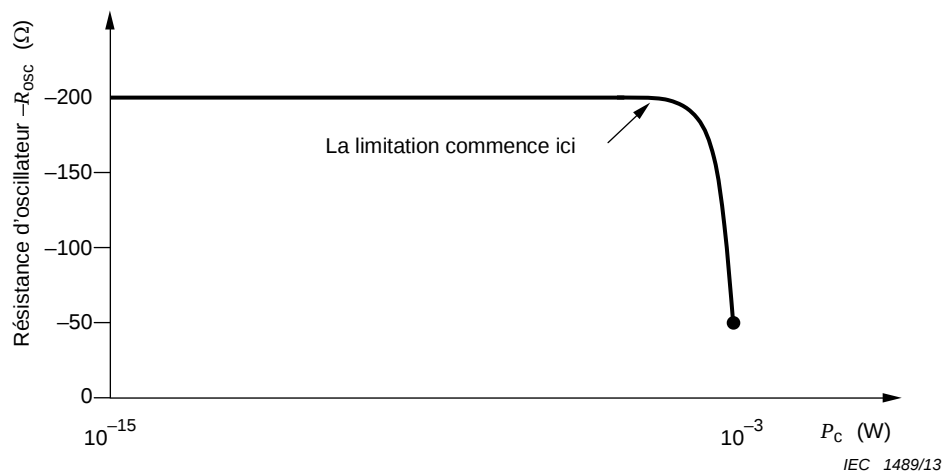


Figure B.5 – $-R_{osc}$ installée dans une gamme de niveaux d'excitation balayés

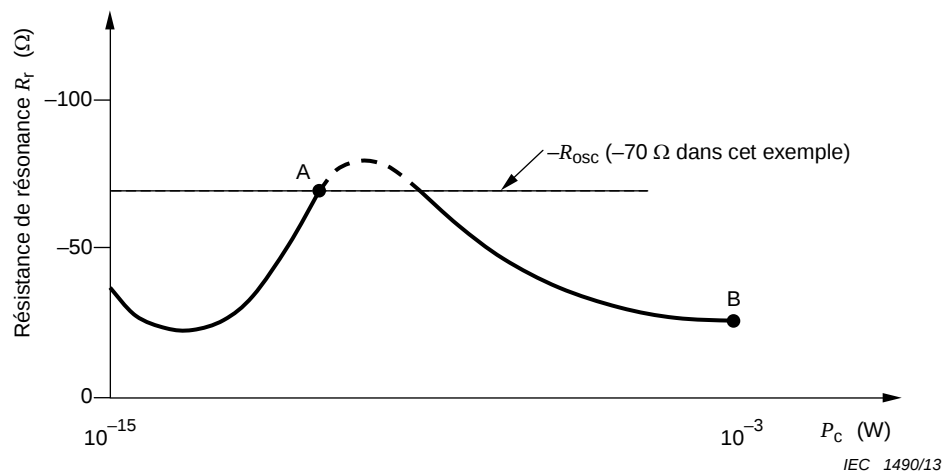


Figure B.6– Comportement du niveau d'excitation d'un résonateur à quartz si $-R_{osc} = 70 \Omega$ est utilisée comme limite de l'essai de l'Annexe B

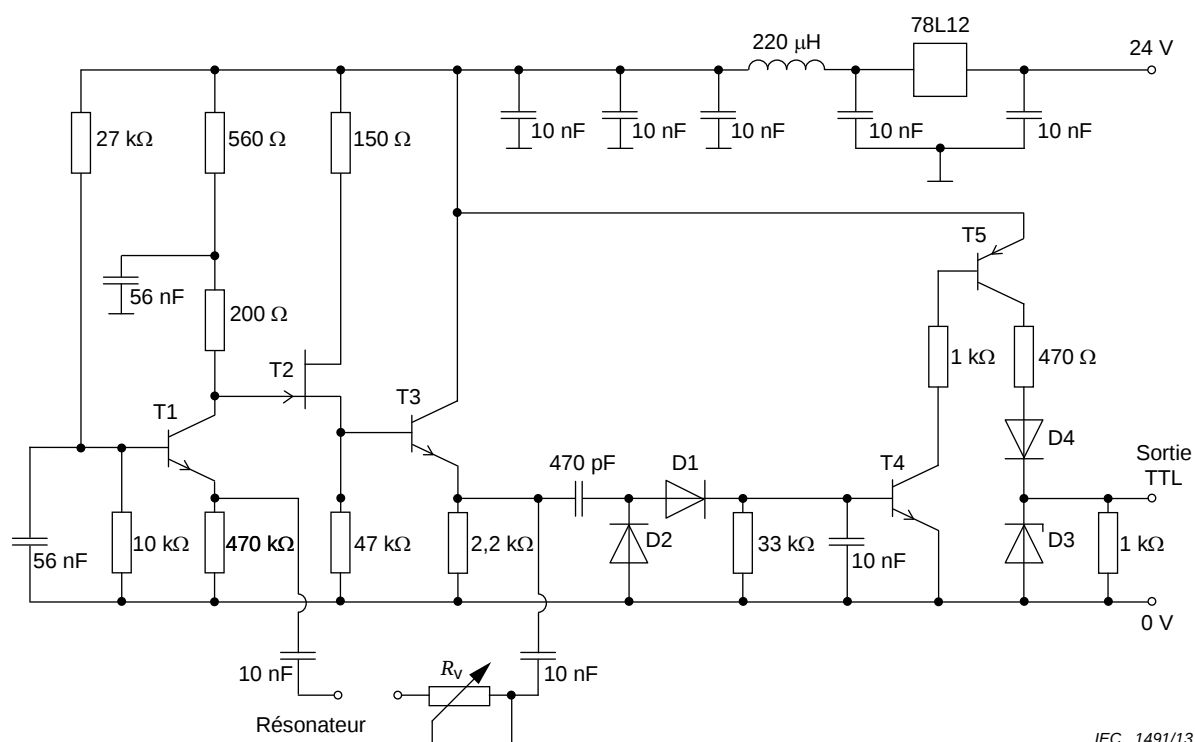


Figure B.7 – Schéma principal du circuit d'essai tout-ou-rien

Bibliographie

CEI 60122-2-1:1991, *Quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence — Deuxième partie: Guide pour l'emploi des résonateurs à quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence — Section un: Résonateurs à quartz comme base de temps dans les microprocesseurs*
Amendement 1:1993

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch